

SY 180/1 ... SY 180/14



Silizium-Leistungsdiode im Metallgehäuse mit Gewindeanschluß M 8

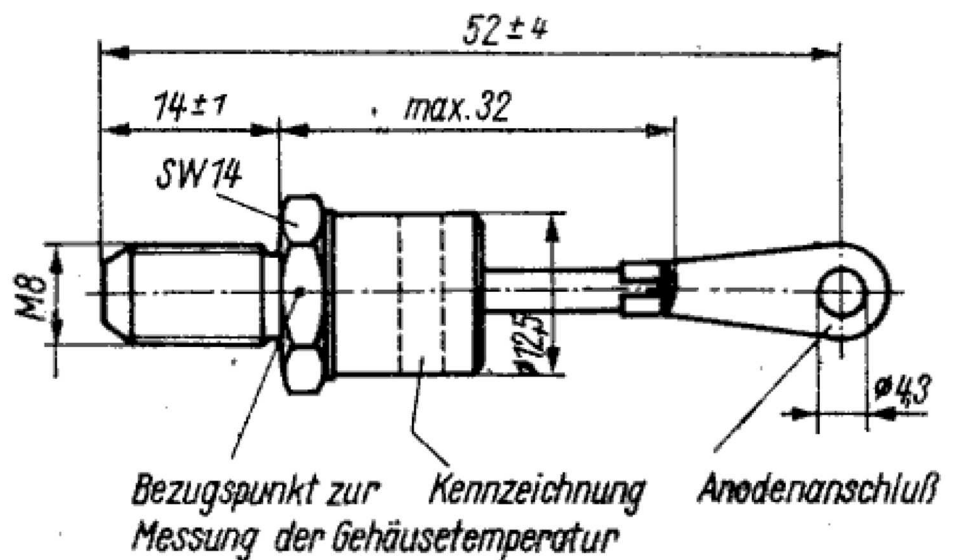
Typ	$U_{RRM}^{1)}$ (V)	$U_{RSM}^{2)}$ (V)	U_{RWM} (V)	U_R (V)	$I_{F(AV)}^{3)}$ (A)	$I_{F(RMS)}$ (A)	$I_{FSM}^{4)}$ (A)
SY 180/1		100		70			
2		200		140			
4		400		280			
6		600		420			
8		800		560	30	47	420
10		1000		700			
12		1200		840			
14		1400		980			

- Sperrschichttemperatur $-55\text{ }^{\circ}\text{C}$ bis $150\text{ }^{\circ}\text{C}$

¹⁾ $\frac{t_p}{T}$ (von U_R) $\leq 0,5$; $f = 50\text{ Hz} \dots 400\text{ Hz}$

²⁾ $t_p \leq 20\text{ ms}$ ³⁾ Sinushalbwellen, $\theta_c = 100\text{ }^{\circ}\text{C}$

⁴⁾ Sinushalbwellen, $f = 40\text{ Hz} \dots 65\text{ Hz}$, $\theta_j = 150\text{ }^{\circ}\text{C}$



(1mal biegen der Fahne um 90° zulässig; Stellung der Fahne zum Sechskant unverbindlich)